

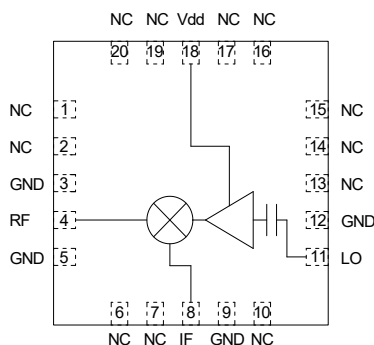
关键指标

- RF/LO 频段：0.9~3GHz
- IF 频段：DC~0.8GHz
- 变频损耗：8dB
- 本振功率：+0dBm
- 芯片尺寸：5mm×5mm×1.3mm

典型应用

- 雷达和电子对抗
- RF/微波电路
- 军事和航天
- 测试仪器
- 仪器仪表

功能框图



产品简介

XT3507AQ5 是一款 GaAs MMIC 无源双平衡混频器变频芯片，芯片射频频率覆盖 0.9~3.0GHz，本振频率覆盖 0.9~3.0GHz，中频频率覆盖 DC~0.8GHz，变频损耗典型值 8dB，典型本振输入功率为 0dBm。

电性能 ($T_A=25^{\circ}\text{C}$, $\text{LO}=+0\text{dBm}$, $V_D=+5\text{V}$, $I_D=38\text{mA}$)

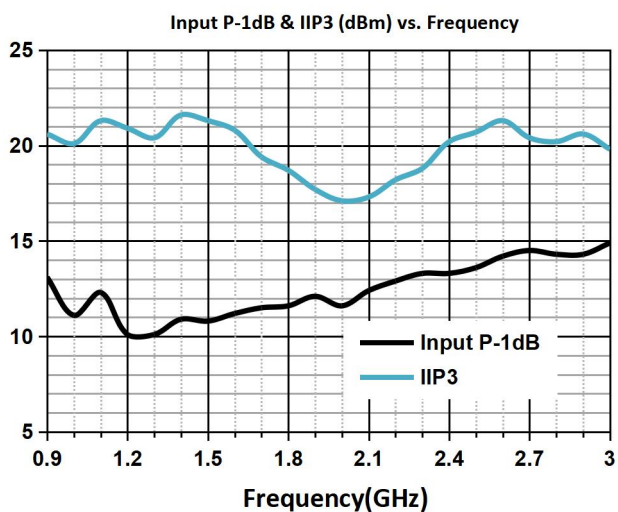
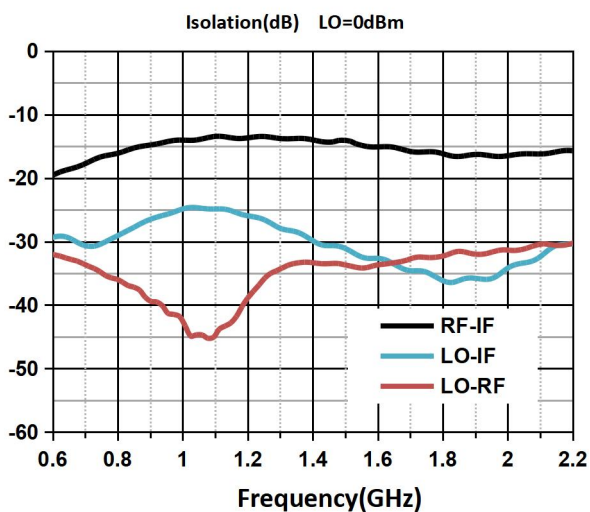
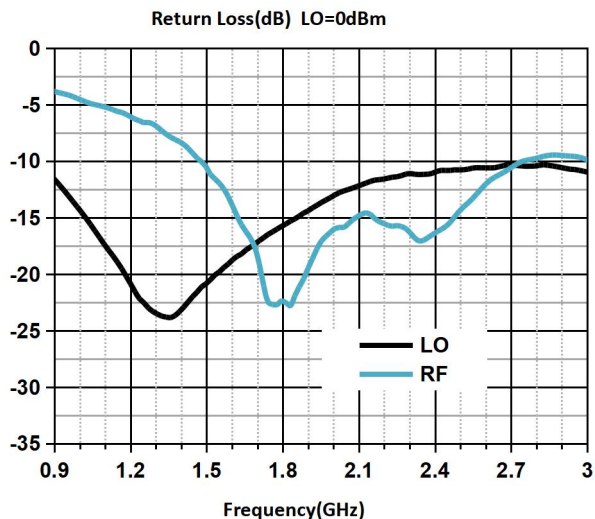
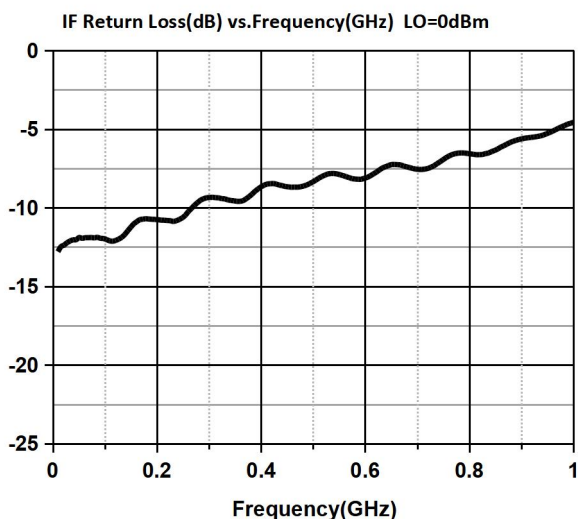
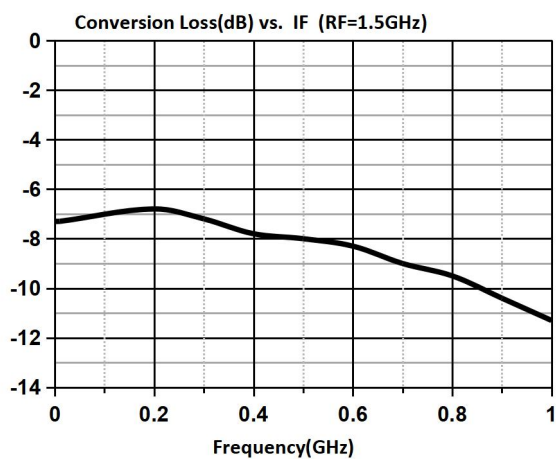
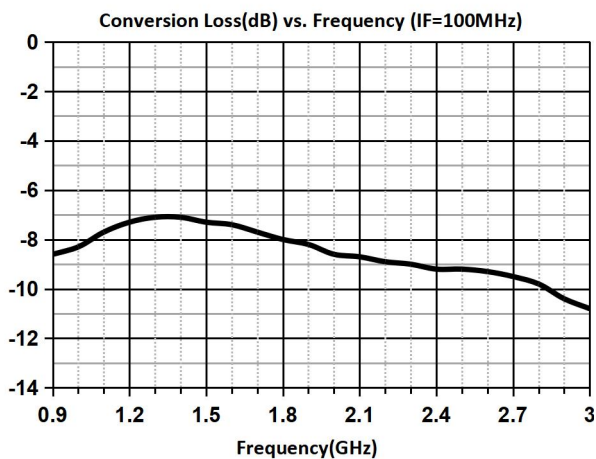
指标	最小值	典型值	最大值	单位
射频/本振频率	0.9~3.0			GHz
中频频率	DC~0.8			GHz
变频损耗	—	-8	—	dB
IF 端回波损耗	—	-10	—	dB
RF 端回波损耗	—	-10	—	dB
LO 端回波损耗	—	-15	—	dB
本振-射频隔离度	—	-35	—	dB
本振-中频隔离度	—	-30	—	dB
射频-中频隔离度	—	-18	—	dB

绝对最大额定值

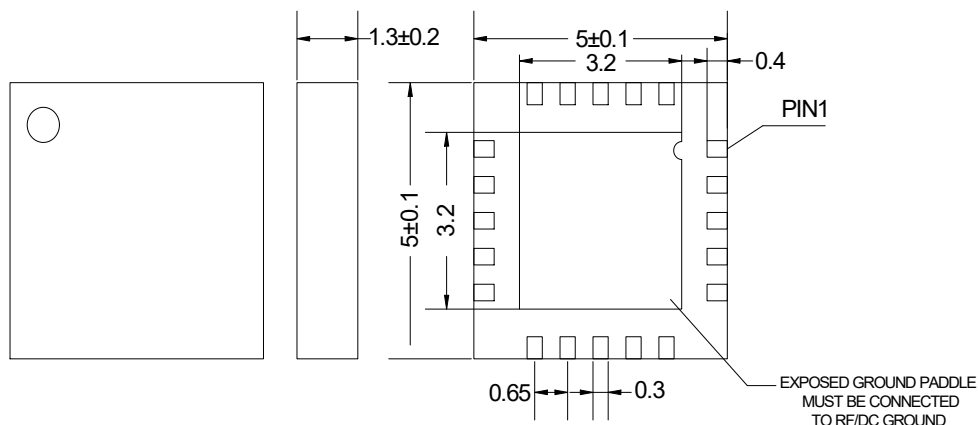
射频最大输入功率	+20dBm	工作温度	-55℃~+85℃
本振最大输入功率	+10dBm	存储温度	-65℃~+150℃
		最大电源电压	+8V



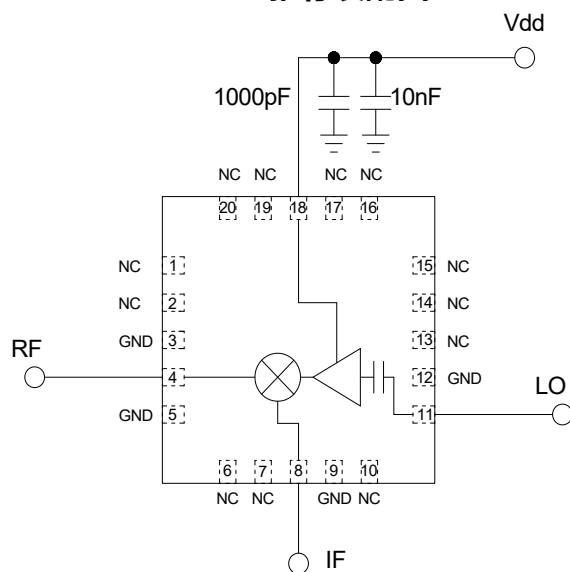
典型测试曲线



外形和端口尺寸 (mm)



推荐装配图



注意事项

砷化镓 MMIC 器件易受静电放电损伤。在运输、装配和试验过程中应采取防范措施。

特殊说明

2020 年 16 周后封装工艺变化。采用和封装壳体相同材质的盖子。厚度从原 1.2mm±0.1mm 变为 1.3mm±0.2mm